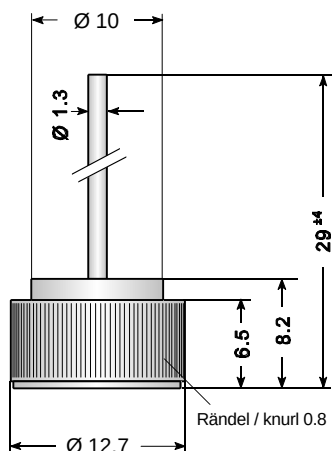


Silicon Press-Fit-Diodes
Silizium-Einpreßdioden


Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom 25 A

Repetitive peak reverse voltage 50...400 V
Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with plastic cover
Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings
Grenzwerte

Type / Typ Wire is / Draht ist		Rep. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung
Kathode	Anode	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
KYP 70	KYP 75	50	60
KYP 71	KYP 76	100	120
KYP 72	KYP 77	200	240
KYP 73	KYP 78	300	360
KYP 74	KYP 79	400	480

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 25 A
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

Repetitive peak forward current $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 80 A ¹⁾
Periodischer Spitzenstrom

Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 375 A²s
Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$

Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 300 A
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen

¹⁾ Valid, if the temperature of the case is kept to 100°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf 100°C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	– 50...+175 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	– 50...+175 °C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 25\text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 1 K/W

